

「CMOSモデリング技術」正誤表

該当箇所	内容	
	誤	正
P4の2行目	1.1.3 デルパラメータの抽出	1.1.3 モデルパラメータの抽出
P106の20行目	電圧効果	電圧降下
P123の25～27行目	小チャネル	狭チャネル
P146の1行目	図4.9	図4.10
P214の27行目	V_{r1}	V_{r2}
P226の10行目	C_{SB}	C_{JS}
P226の10行目	C_{DB}	C_{JD}
P260の14～16行目	小チャネル	狭チャネル
P268の式(9.17)	$STUN$	$ISTUN$
P270の21行目	$VDSATII$	V_{dsatII}
P271の21行目	$VETB$	$VEVB$
P274の12行目	Q_{ds}	Q_{jd}
P276の式(9.68)	Q_{sub0}	Q_{subs}
P278の12行目	C_{essw}	C_{sesw}
P278の12行目	C_{edsw}	C_{desw}
P279	図9.17の表題漏れ	図9.17 SOI-MOSFETの温度依存と自己発熱モデルの関係
P280の式(9.80)	n_{recf0}	$NRECF0$